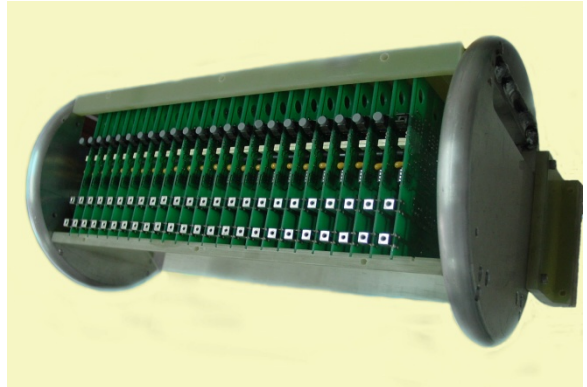
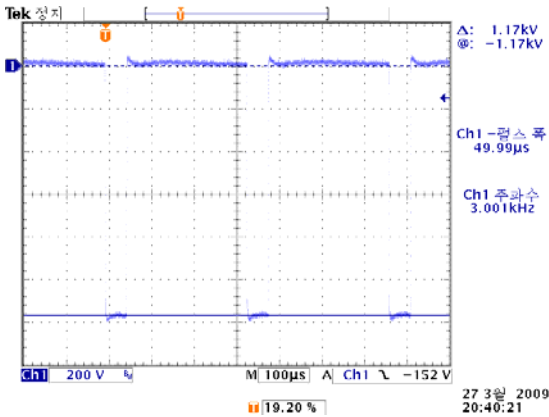


High voltage semiconductor switch

FET, IGBT를 이용한 고전압 switch는 Hard type pulser를 만드는데 반드시 필요한 장비이다. IGBT, FET 소자기술의 발전에 따라 대용량의 반도체 switch 제작이 가능해 졌다. 당사에서 공급하는 제품은 80kV/10A, 1mS 이하 급의 반도체 switch를 생산하고 있다. 가속기의 E-GUN, Pulse Plasma 전원의 출력 switch로 사용하고 있다. 사용자의 요구에 따라 주문 생산이 가능하며 Nano second 급은 개발 중에 있다.



List	Value	Unit	Remark
Operating Voltage	100 ~ 80,000	V	
Switching current	< 10	A	
Peak current (Icm)	< 200	A	500uS Max *
Polarity	Positive , Negative		
Turn ON Delay	<300	nS	
Turn OFF Delay	<1100	nS	
Rising time	< 700	nS	
Falling time	Decay free by load condition		
Trigger	Fiber optic		
Bias voltage	External power with single turn		

* Not repeatable